

带保护的D 类音频驱动IC——IRS2092


产品概述

IRS2092电路是一款高耐压、高速的MOSFET栅极驱动器，专为超大输出功率的D类音频功率放大器应用而设计。采用灵活的开放式拓扑结构实现PWM调制。

该产品具有双向过流检测与保护功能。该保护在没有任何外部采样电阻的情况下，感应负载正、负电流的过电流情况，并提供合适的过电流保护和可编程的复位定时。

该产品内置死区时间控制模块，精确设置MOSFET栅极开关的死区时间，以获得极低的THD和更小的音频输出背景噪声。

引脚排列

		SOP16	
VAA	1	16	CSH
GND	2	15	VB
IN-	3	14	HO
COMP	4	13	VS
CSD	5	12	VCC
VSS	6	11	LO
VREF	7	10	COM
OCSET	8	9	DT

主要特点

- ① 集成模拟输入 D 类音频放大驱动器
- ② 可编程负载双向过流保护，具有自复位功能
- ③ 可编程预设死区时间，提高 THD 性能
- ④ 具有防开启期间和关闭期间的“咔哒”声
- ⑤ 较好的背景噪声抑制
- ⑥ 额定电压±100 V，输出功率超过 500 W
- ⑦ 工作频率最高可达 800 kHz
- ⑧ 驱动级输出电流能力 $I_{O+/-} = 1.0A/1.5A$
- ⑨ 双列 16 脚塑料封装(SOP16)
- ⑩ 符合 RoHS

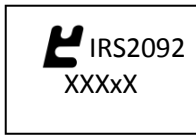
典型应用

- ① 车载信息娱乐系统
- ② 家庭影院系统
- ③ 大功率舞台音响系统
- ④ 通用音频功率放大器

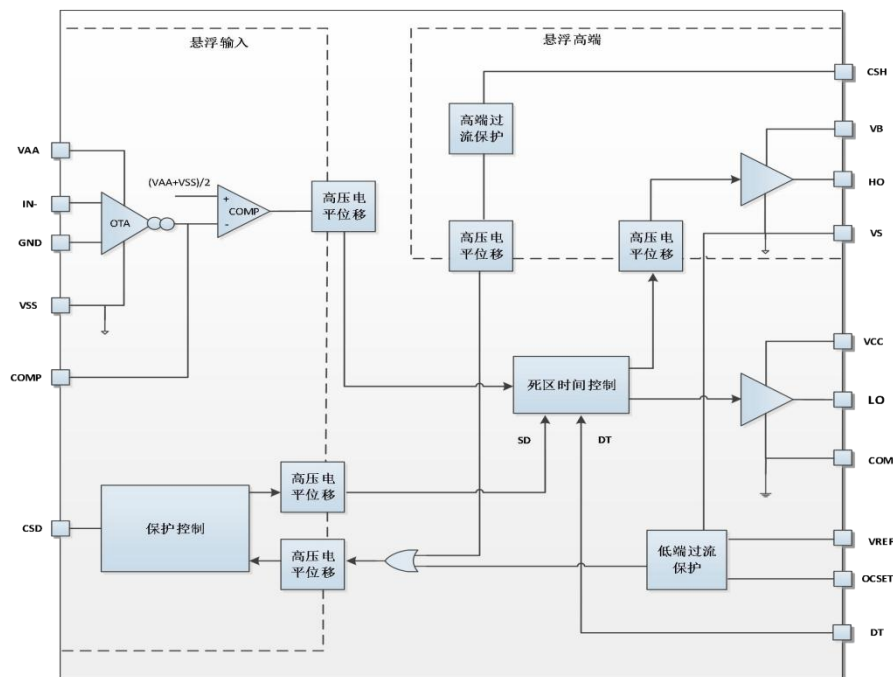
引出端功能

序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述
1	VAA	输入级正电源	9	DT	死区调节
2	GND	跨导放大器正输入	10	COM	下桥臂公共端
3	IN-	跨导放大器负输入	11	LO	下桥臂驱动输出
4	COMP	相位补偿	12	VCC	下桥臂电源
5	CSD	保护延时设定	13	VS	上桥臂悬浮端
6	VSS	输入级负电源	14	HO	上桥臂驱动输出
7	VREF	基准电压源	15	VB	上桥臂自举电源
8	OCSET	过流阈值设定	16	CSH	上桥臂过流采样

订货信息

产品名	封装形式	打印标记	装料形式	最小包装数
IRS2092	SOP16		编带	4k/卷

电路方框图



最大额定值（无特别说明情况下， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）

符号	参数	最小值	最大值	单位
V_B	高端浮动电源电压	-0.3	220	V
V_S	高端浮动电源电压(注 2)	V_B-20	$V_B+0.3$	
V_{HO}	高端浮动输出电压	$V_S-0.3$	$V_B+0.3$	
V_{CSH}	CSH 脚输入电压	$V_S-0.3$	$V_B+0.3$	
V_{CC}	低端固定电源电压(注 2)	-0.3	20	
V_{LO}	低端输出电压	-0.3	$V_{CC}+0.3$	
V_{AA}	浮动输入正电源电压(注 2)	(见 I_{AAZ})	210	
V_{SS}	浮动输入负电源电压(注 2)	-1 (见 I_{SSZ})	GND+0.3	
V_{GND}	浮动输入电源地电压	$V_{SS}-0.3$ (见 I_{SSZ})	$V_{AA}+0.3$ (见 I_{AAZ})	
I_{IN-}	反向输入电流(注 1)	-	± 3	mA
V_{CSD}	CSD 脚输入电压	$V_{SS}-0.3$	$V_{AA}+0.3$	V
V_{COMP}	COMP 脚输入电压	$V_{SS}-0.3$	$V_{AA}+0.3$	
V_{DT}	DT 脚输入电压	-0.3	$V_{CC}+0.3$	
V_{OCSET}	OCSET 脚输入电压	-0.3	$V_{CC}+0.3$	
I_{AAZ}	VAA 浮动输入正向钳位电流(注 2)	-	20	mA
I_{SSZ}	VAA 浮动输入负向钳位电流(注 2)	-	20	
I_{CCZ}	VCC 低端输入钳位电流(注 2)	-	10	
I_{BSZ}	VB 浮动输入钳位电流(注 2)	-	10	
I_{OREF}	VREF 参考端输出电流	-	5	
dV_S/dt	VS 允许的电压变化斜率	-	50	V/ns
dV_{SS}/dt	VSS 允许的电压变化率(注 3)	-	50	V/ms
P_D	最大功耗	-	1.0	W
R_{thJA}	热阻	-	115	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
T_J	结温	-	150	$^{\circ}\text{C}$
T_S	储存温度	-55	150	
T_L	焊接温度(焊接, 10 秒)	-	300	

如果器件运行条件超过上述各项最大额定值，可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运行条件的极大值，我们不建议器件在该规范外运行。如果器件长时间工作在最大极限条件下，其稳定性可能会受到影响。

注1: IN-到 GND 有双向箝位二极管。

注2: VAA-GND, GND-VSS, VCC-COM 和 VB-VS 脚包含内部的分流用齐纳二极管。请注意这些电压值会受到钳位电流的限制。

注3: 对于10V 阶跃信号的上升沿和下降沿, $V_{SS}=15\text{V}\sim 200\text{V}$ 。

推荐工作条件（无特别说明情况下，下表中 V_S 及 COM 偏置的额定值是在 $V_{AA}-V_{SS}=10V$ ， $V_{CC}=12V, V_B-V_S=12V$ 条件下测得，所有电压参数的额定值是以 COM 为参考。电流参数以流入端口为正。 $T_A=25^\circ C$ ）

符号	参数	最小值	最大值	单位	
V_B	高端浮动电源额定电压	V_S+10	V_S+18	V	
V_S	高端浮动电源偏置电压	(注1)	200		
I_{AAZ}	浮动输入电源正向箝位电流	3	15	mA	
I_{SSZ}	浮动输入电源负向箝位电流	3	15		
V_{SS}	浮动输入额定电压	0	200	V	
V_{HO}	高端浮动输出电压	V_S	V_B		
V_{CC}	低端额定电源电压	10	18		
V_{LO}	低端输出电压	0	V_{CC}		
V_{GND}	GND 输入电压	V_{SS} (注3)	V_{AA} (注3)		
V_{IN-}	反向输入电压	$V_{GND}-0.5$	$V_{GND}+0.5$		
V_{CSD}	CSD 脚输入电压	V_{SS}	V_{AA}		
V_{COMP}	COMP 脚输入电压	V_{SS}	V_{AA}		
C_{COMP}	COMP 脚对 GND 的相位补偿电容	1	-		nF
V_{DT}	DT 脚输入电压	0	V_{CC}		V
I_{OREF}	VREF 参考输出电流 (注 2)	0.3	0.8	mA	
V_{OCSET}	OCSET 脚输入电压	0.5	5		
V_{CSH}	CSH 脚输入电压	V_S	V_B	V	
dV_{SS}/dt	上电时 V_{SS} 允许的电压变化率(注 4)	-	50	V/ms	
I_{PW}	输入脉宽	10(注5)	-	ns	
f_{SW}	开关频率	-	800	kHz	
T_A	环境温度	-40	125	$^\circ C$	

注 1: V_S 端逻辑电平可从 $-5 \sim +200V$ 变化、实际逻辑状态从 $-5 \sim -V_B$ 间工作。

注 2: V_{REF} 相对 COM 参考电压 $5V$ ，当 V_{REF} 外接 $6.3k\sim 16.7k\Omega$ 时, I_{OREF} 从 $0.3\sim 0.8mA$ 变化。注 3: GND 脚电压受限于 I_{AAZ} 及 I_{SSZ} 。

注 4: 对于 $10V$ 阶跃信号的上升沿和下降沿， $V_{SS}=0V\sim 200V$ 。注 5: 若输入脉宽小于最小脉宽设定，输出逻辑态可能出错。

电气参数（无特别说明情况下， $V_{CC}, V_{BS}=12V, V_{AA}=10V, V_{SS}=V_S=COM=0V, CL=1nF$ 以及 $TA=25^{\circ}C$ ）

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
低端电源						
UV_{CC+}	V_{CC} 输入 UVLO 正阈值	8.4	8.9	9.4	V	
UV_{CC-}	V_{CC} 输入 UVLO 负阈值	8.2	8.7	9.2		
I_{QCC}	低端静态电流	-	-	3	mA	$V_{DT}=V_{CC}$
V_{CLAMPL}	低端钳位电压	19.6	20.4	21.6	V	$I_{CC}=5mA$
高端浮动电源						
UV_{BS+}	高端 UVLO 正阈值	8	8.5	9	V	
UV_{BS-}	高端 UVLO 负阈值	7.8	8.3	8.8		
I_{QBS}	高端静态电流	-	-	1	mA	
I_{LKH}	高端到低端漏电流	-	-	50	uA	$V_B=V_S=200V$
V_{CLAMPH}	高端钳位电压	19.6	20.4	21.6	V	$I_{BS}=5mA$
浮动输入电源						
UV_{AA+}	V_{AA} 输入 UVLO 正阈值	8.2	8.7	9.2	V	$V_{SS}=0V$
UV_{AA-}	V_{AA} 输入 UVLO 负阈值	7.7	8.2	8.7		$V_{SS}=0V$
I_{QAA0}	V_{AA} 输入静态电流	-	0.5	2	mA	$V_{AA}=10V, V_{CSD}=V_{SS}$
I_{QAA1}	V_{AA} 输入静态电流	-	6.5	10		$V_{AA}=10V, V_{CSD}=V_{AA}$
I_{QAA2}	V_{AA} 输入静态电流	-	6.5	10		$V_{AA}=10V, V_{CSD}=GND$
I_{LKM}	V_{AA} 浮动输入端到低端漏电流	-	-	50	uA	$V_{AA}=V_{SS}=V_{GND}=100V$

V_{CLAMP+}	V_{AA} 对 GND 正钳位电压	6.0	7.0	8.0	V	$I_{AA}=I_{SS}=10\text{mA}$ $V_{GND}=0\text{V}$, $V_{CSD}=V_{SS}$
V_{CLAMP-}	V_{SS} 对 GND 负钳位电压	-8.0	-7.0	-6.0		$I_{AA}=I_{SS}=10\text{mA}$ $V_{GND}=0\text{V}$, $V_{CSD}=V_{SS}$
音频输入 ($V_{GND}=0\text{V}$, $V_{AA}=5\text{V}$, $V_{SS}=-5\text{V}$)						
V_{OS}	输入偏移电压	-15	0	15	mV	
I_{BIN}	输入偏置电流	-	-	40	nA	
BW	小信号带宽	-	9	-	MHz	$R_f=3.3\text{k}$, $C_{COMP}=2\text{nF}$
V_{COMP}	OTA 输出电压	$V_{AA}-1$	-	$V_{SS}+1$	V	
g_m	OTA 跨导	-	100	-	ms	$V_{IN}=5\text{mV}$
G_v	OTA 增益	60	-	-	dB	
$V_{N_{rms}}$	OTA 输入噪声电压	-	250	-	mVrms	
SR	摆率		± 5		V/us	$C_{COMP}=1\text{nF}$
CMRR	共模抑制比		60		dB	
PSRR	电源抑制比		65			
PWM 比较器						
$V_{th_{PWM}}$	COMP 门限电压	-	$(V_{AA}-V_{SS})/2$	-	V	
f_{OTA}	COMP 启动时本振频率	0.7	1.0	1.5	MHz	$V_{CSD}=GND$
保护						
V_{REF}	基准输出电压	4.8	5.1	5.4	V	$I_{OREF}=0.5\text{mA}$
$V_{th_{OCL}}$	低端 OC 阈值	1.1	1.2	1.3		$O_{CSET}=1.2\text{V}$, 见图 3
$V_{th_{OCH}}$	VCSH 的高端 OC 阈值	$1.1+V_S$	$1.2+V_S$	$1.3+V_S$		$V_S=200\text{V}$
V_{th1}	CSD 脚关闭阈值	$0.62*V_{AA}$	$0.70*V_{AA}$	$0.78*V_{AA}$		$V_{SS}=0\text{V}$
V_{th2}	CSD 脚自复位阈值	$0.26*V_{AA}$	$0.30*V_{AA}$	$0.34*V_{AA}$		$V_{SS}=0\text{V}$
I_{CSD+}	CSD 脚放电电流	70	100	130	uA	$V_{CSD}=V_{SS}+5\text{V}$
I_{CSD-}	CSD 脚充电电流	70	100	130		$V_{CSD}=V_{SS}+5\text{V}$
t_{SD}	$V_{CSD} > V_{SS}+V_{th_{OCH}}$ 关闭传播延迟时间	-	-	250	ns	见图 2
t_{OCL}	$V_S > V_{th_{OCL}}$ 关闭传播延迟时间	-	-	500		见图 3
t_{OCH}	$V_{CSH} > V_{th_{OCH}}$ 关闭传播延迟时间	-	-	500		见图 4

栅极驱动						
I_{o+}	输出高短路电流	-	1.0	-	A	$V_o=0V, PW<10\mu s$
I_{o-}	输出低短路电流	-	1.5	-		$V_o=12V, PW<10\mu s$
V_{OL}	低电平输出电压 LO-COM, HO-VS	-	-	0.1	V	$I_o=0A$
V_{OH}	高电平输出电压 VCC-LO, VB-HO	-	-	1.0	V	
t_r	开启上升时间	-	20	50	ns	
t_f	关闭下降时间	-	15	35		
t_{on}	高端和低端开启传播延迟, 浮动输入	-	385	-		
t_{off}	高端和低端关闭传播延迟, 浮动输入	-	360	-		$V_{DT}=V_{CC}$, 见图 1
DT1	死区时间: LO 关闭到 HO 打开以及 HO 关闭到 LO 打开	15	25	35		$V_{DT}>V_{DT1}$, 见图 1
DT2	死区时间: LO 关闭到 HO 打开(DTLO-HO) 以及 HO 关闭到 LO 打开 (DTHO-LO)	25	40	55		$V_{DT1}>V_{DT}>V_{DT2}$, 见图 1
DT3	死区时间: LO 关闭到 HO 打开(DTLO-HO) 以及 HO 关闭到 LO 打开 (DTHO-LO)	50	65	85		$V_{DT2}>V_{DT}>V_{DT3}$, 见图 1
DT4	死区时间: LO 关闭到 HO 打开(DTLO-HO) 以及 HO 关闭到 LO 打开 (DTHO-LO)	85	105	135		$V_{DT3}>V_{DT}>V_{DT4}$, 见图 1
V_{DT1}	DT 模式选择阈值 2	$0.51*V_{CC}$	$0.57*V_{CC}$	$0.63*V_{CC}$	V	
V_{DT2}	DT 模式选择阈值 3	$0.32*V_{CC}$	$0.36*V_{CC}$	$0.40*V_{CC}$		
V_{DT3}	DT 模式选择阈值 4	$0.21*V_{CC}$	$0.23*V_{CC}$	$0.25*V_{CC}$		

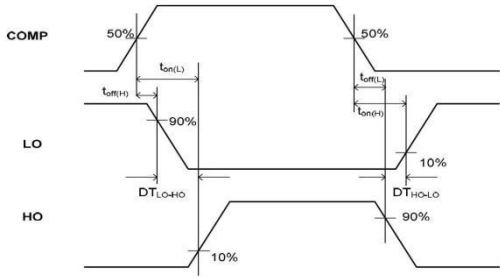


图 1 COMP 到 LO 和 HO 延时

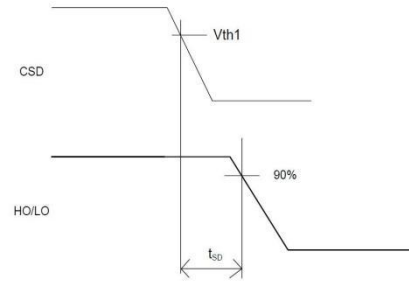


图 2 CSD 保护延时

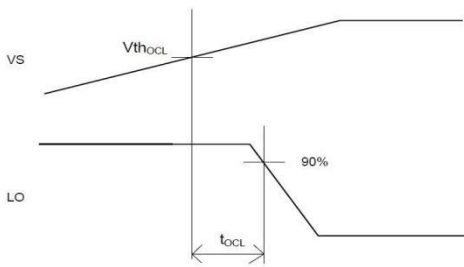


图 3 VS>VthOCL 保护延时

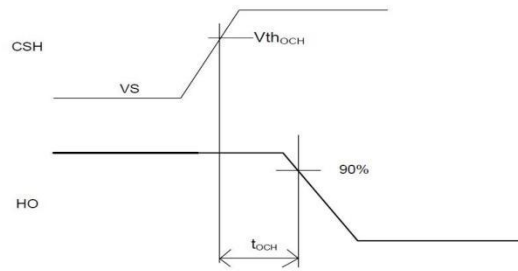


图 4 VCSH>VthOCH 保护延时

应用电路

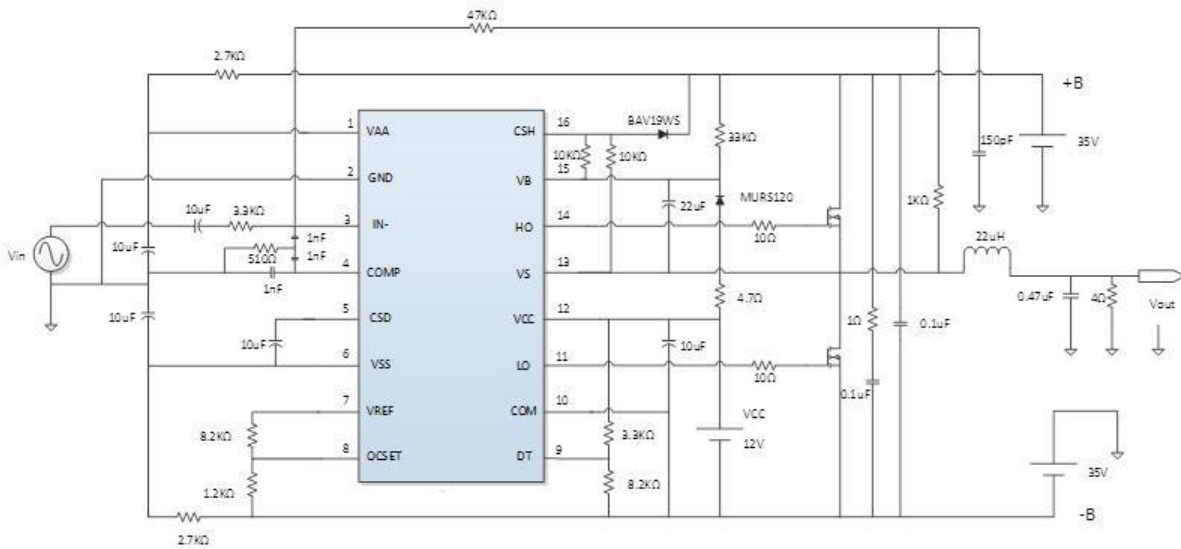
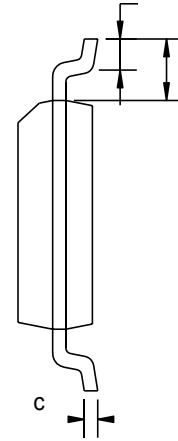
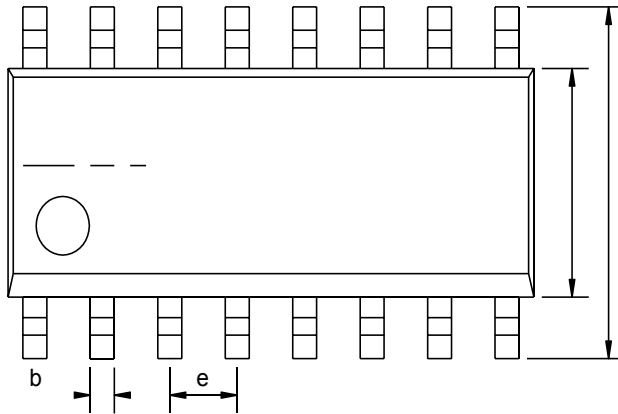
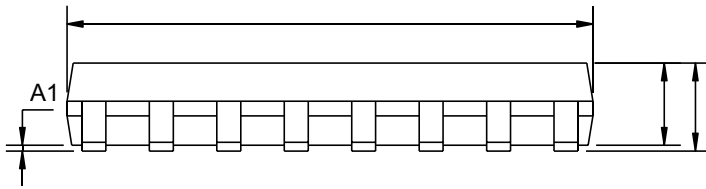


图 5 典型应用图

封装外形图和尺寸

SOP16



SYMBOL	mm	
	min	max
A		1.75
A1	0.05	0.23
A2	1.30	1.50
b	0.35	0.45
c	0.18	0.25
D	9.70	10.10
E	5.80	6.20
E1	3.70	4.10
e	1.27BSC	
L	0.50	0.80
L1	1.05BSC	



NOTE:

Exceeding the maximum ratings of the device in performance may cause damage to the device, even the permanent failure, which may affect the dependability of the machine. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing.

1. When installing the heat sink, please pay attention to the torsional moment and the smoothness of the heat sink.
2. MOSFETs is the device which is sensitive to the static electricity, it is necessary to protect the device from being damaged by the static electricity when using it.
3. Shenzhen Minos reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice.

CONTACT:

深圳市迈诺斯科技有限公司 (总部)

地址：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4026号田面城市大厦22B-22C

邮编：518025

电话：0755-83273777